
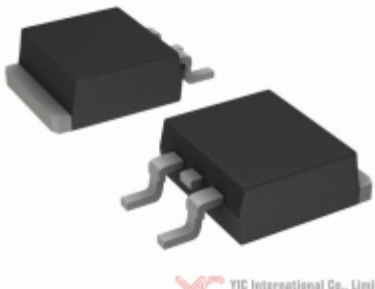




	<h2 style="color: red;">FQB8N60CTM</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQB8N60CTM</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 7.5A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  FQB8N60CTM.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 9707 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQB8N60CTM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 7.5A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	9707 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	16 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 7.5A (Tc) 3.13W (Ta), 147W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 147W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.2 Ohm @ 3.75A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	36nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1255pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Original-Reel®
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQB8N60CTMFSDKR































FQB8N60CTM ist neu im Original, Suche FQB8N60CTM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQB8N60CTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQB8N60CTM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 FQB8N60TM FAI FQB8N60TM FAI	 FQB8N60CFTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 6.26A D2PAK	 FQB8N60CS Fairchild/ON Semiconductor FQB8N60CS FAIRCHILD	 FQB8N60C FAIRCHI FQB8N60C FAIRCHI
 FQB8N60CFTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 6.26A D2PAK	 FQB8N80 Fairchild/ON Semiconductor FQB8N80 FAIRCHILD	 FQB8N60CTM-WS AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7.5A	 FQB8N60CTM_WS Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7.5A

heiße Teile

Mehr

 FQB6N70TM	 FQB6N90TM	 FQB6N90TM_AM002	 FQB6N90TM_AM002	 FQB7042FB
 FQB7045FB	 FQB70N03	 FQB70N06	 FQB70N08	 FQB70N10TM
 FQB7N10L	 FQB7N20L	 FQB7N60TM	 FQB7N60TM	 FQB7N65C
 FQB7N65CTM	 FQB7N65CTM	 FQB7P20TM	 FQB7P20TM	 FQB85N06
 FQB85N06TM	 FQB8N25TM	 FQB8N25TM	 FQB8N60C	 FQB8N60CFTM
 FQB8N60CFTM	 FQB8N60CTM	 FQB8N60TM	 FQB8N90CTM	 FQB8N90CTM
 FQB8P10TM	 FQB8P10TM	 FQB8P10TM-NL	 FQB9N08L	 FQB9N08LTM
 FQB9N08LTM	 FQB9N25C	 FQB9N25CTM	 FQB9N25CTM	 FQB9N25TM
 FQB9N25TM	 FQB9N50C	 FQB9N50CFTM	 FQB9N50CFTM	 FQB9N50CTM
 FQB9N50CTM	 FQB9N50TM	 FQB9N50TM	 FQB9P25TM	 FQB9P25TM

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

